



独立实验室批准证书

范围附件

IECQ 证书号: IECQ-L CEP 20.0003

CB 证书号: IECQ-L 2020.003

附件号: IECQ-L CEP 20.0003-S

版本号: 4

颁发日期: 2024/10/25

第 1 页 共 6 页

序号	产品/产品类别	项目/参数		检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
		序号	名称	
1	IC (MOS 随机存储器)	1	全“0”全“1”功能测试	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		2	校验板功能测试	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		3	输出高电平电压 V_{OH}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		4	输出低电平电压 V_{OL}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		5	输入负载电流 I_{LI}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		6	工作状态电源电流 I_{CC}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		7	维持状态电源电流 I_{CCS}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
2	IC (电压调整器)	1	输出电压 V_o	半导体集成电路电压调整测试方法 GB/T 4377-2018
		2	电压调整率 S_v	半导体集成电路电压调整测试方法 GB/T 4377-2018
		3	电流调整率 S_i	半导体集成电路电压调整测试方法 GB/T 4377-2018
3	IC (模拟开关)	1	模拟开关工作范围 V_A	半导体集成电路模拟开关测试方法 GB/T 14028-2018
4	IC (DC-DC 变换器)	1	输出电压 V_o	混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法 SJ 20646-1997
		2	输出电流 I_o	混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法 SJ 20646-1997
		3	电压调整率 S_v	混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法 SJ 20646-1997
		4	电流调整率 S_i	混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法 SJ 20646-1997

本附件与引用的证书同时使用时有效

本证书与附件如需复制使用, 应确保其完整性

本证书不得转让, 归发证机构管理

验证本证书与附件的状态和真实性可登陆 www.iecq.org 查询

广州赛宝认证中心服务有限公司

广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号 (511370)





独立实验室批准证书

范围附件

IECQ 证书号: IECQ-L CEP 20.0003

CB 证书号: IECQ-L 2020.003

附件号: IECQ-L CEP 20.0003-S

版本号: 4

颁发日期: 2024/10/25

第 2 页 共 6 页

5	IC (微处理器)	1	输入高电平电流 I_{IH}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		2	输入低电平电流 I_{IL}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		3	静态工作电流 I_{SB}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		4	动态工作电流 I_A	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		5	功能测试 test	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		6	输出高电平电压 V_{OH}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		7	输出低电平电压 V_{OL}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		8	输入高电平电压 V_{IH}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
		9	输入低电平电压 V_{IL}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998
6	电阻 (固定电阻器、金属膜电阻器、薄膜电阻器、线绕电阻器、电位器)	1	标称阻值	电子设备用固定电阻器 第 1 部分: 总规范 GB/T 5729-2003
		2	终端电阻	电子设备用电位器 第 1 部分: 总规范 GB/T 15298-1994
7	二极管 (稳压二极管、开关二极管、整流二极管、肖特基二极管、瞬态抑制二极管、发光二极管、硅功率开关二极管)	1	正向电压	半导体器件分立器件和集成电路 第 2 部分: 整流二极管 GB/T 4023-2015
		2	反向电流	半导体器件分立器件和集成电路 第 2 部分: 整流二极管 GB/T 4023-2015
		3	击穿电压	半导体器件分立器件和集成电路 第 2 部分: 整流二极管 GB/T 4023-2015
		4	工作电压	半导体分立器件 第 3 部分: 信号 (包括开关) 和调整二极管 GB/T 6571-1995
		5	微分电阻	半导体分立器件 第 3 部分: 信号 (包括开关) 和调整二极管 GB/T 6571-1995

本附件与引用的证书同时使用时有效

本证书与附件如需复制使用, 应确保其完整性

本证书不得转让, 归发证机构管理

验证本证书与附件的状态和真实性可登陆 www.iecq.org 查询

广州赛宝认证中心服务有限公司

广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号 (511370)





独立实验室批准证书

范围附件

IECQ 证书号: IECQ-L CEP 20.0003

CB 证书号: IECQ-L 2020.003

附件号: IECQ-L CEP 20.0003-S

版本号: 4

颁发日期: 2024/10/25

第 3 页 共 6 页

8	三极管 (开关三极管、功率三极管)	1	集电极-基极击穿电压	半导体分立器件和集成电路 第七部分: 双极型晶体管 GB/T 4587-1994
		2	发射极-基极击穿电压	半导体分立器件和集成电路 第七部分: 双极型晶体管 GB/T 4587-1994
		3	集电极-基极截止电流	半导体分立器件和集成电路 第七部分: 双极型晶体管 GB/T 4587-1994
		4	集电极-发射极饱和电压	半导体分立器件和集成电路 第七部分: 双极型晶体管 GB/T 4587-1994
		5	发射极-基极截止电流	半导体分立器件和集成电路 第七部分: 双极型晶体管 GB/T 4587-1994
		6	集电极-发射极截止电流	半导体分立器件和集成电路 第七部分: 双极型晶体管 GB/T 4587-1994
		7	共发射极正向电流传输比	半导体分立器件和集成电路 第七部分: 双极型晶体管 GB/T4587-1994
9	场效应管 (结型场效应管、绝缘栅型场效应管)	1	漏源击穿电压	半导体分立器件试验方法 第 3 部分 试验方法 3000 到 3999 MIL-STD-750-3-2019 方法 3407.1
		2	阈值电压	半导体器件 分立器件 第 8 部分: 场效应晶体管 GB/T 4586-1994 第 IV 章第 6 条
		3	栅极截止电流	半导体器件 分立器件 第 8 部分: 场效应晶体管 GB/T 4586-1994 第 IV 章第 2 条
		4	漏极电流	半导体器件 分立器件 第 8 部分: 场效应晶体管 GB/T 4586-1994 第 IV 章第 3 条
		5	通态漏源电阻	半导体器件 分立器件 第 8 部分: 场效应晶体管 GB/T 4586-1994 第 IV 章第 16 条

本附件与引用的证书同时使用时有效

本证书与附件如需复制使用, 应确保其完整性

本证书不得转让, 归发证机构管理

验证本证书与附件的状态和真实性可登陆 www.iecq.org 查询

广州赛宝认证中心服务有限公司

广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号 (511370)





国际电工委员会质量评定体系 (IECQ)

IECQ 规则及详情, 请登陆 www.iecq.org

独立实验室批准证书

范围附件

IECQ 证书号: IECQ-L CEP 20.0003

CB 证书号: IECQ-L 2020.003

附件号: IECQ-L CEP 20.0003-S

版本号: 4

颁发日期: 2024/10/25

第 4 页 共 6 页

10	AECQ-100 集成电路试验	1	预处理	非密封表面贴装器件的湿度/回流焊敏感度分级 JEDEC J-STD-020F-2022
				非密封表贴器件可靠性试验前 预处理 JEDEC JESD22-A113I-2020
		2	带偏置稳态湿热	带偏置稳态湿热寿命试验 JEDEC JESD22-A101D. 01-2021
		3	带偏置高加速温湿度应力试验	高加速湿热应力试验 JEDEC JESD22-A110E. 01-2021
		4	高压蒸煮	加速湿度抵抗-无偏置高压蒸煮 JEDEC JESD22-A102E-2015
		5	无偏置高加速温湿度应力试验	加速湿度抵抗-无偏置高加速温湿度应力试验 JEDEC JESD22-A118B. 01-2021
		6	无偏置高加速温湿度应力试验	带偏置稳态湿热寿命试验 JEDEC JESD22-A101D. 01-2021
		7	温度循环	温度循环 JEDEC JESD22-A104F. 01-2023
		8	高温贮存寿命	高温存储寿命 JEDEC JESD22-A103E. 01-2021
		9	高温工作寿命	温度、偏置和工作寿命 JEDEC JESD22-A108G-2022
		10	早期寿命失效率	早期寿命失效率 AEC-Q100-008A-2003
		11	非易失性存储器数据擦写保持	非易失存储器程序/擦除耐久性, 数据保持和可操作寿命试验 AEC-Q100-005D1-2012
		12	邦线剪切	引线邦定剪切试验 AEC-Q100-001C-1998
		13	邦线拉力	微电子器件试验方法 MIL-STD-883L-2019 方法 2011. 10
14	可焊性	元器件引脚, 焊端, 焊片, 端子和导线可焊性试验 J-STD-002E-2017		

本附件与引用的证书同时使用时有效

本证书与附件如需复制使用, 应确保其完整性

本证书不得转让, 归发证机构管理

验证本证书与附件的状态和真实性可登陆 www.iecq.org 查询

广州赛宝认证中心服务有限公司

广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号 (511370)





国际电工委员会质量评定体系 (IECQ)

IECQ 规则及详情, 请登陆 www.iecq.org

独立实验室批准证书

范围附件

IECQ 证书号: IECQ-L CEP 20.0003

CB 证书号: IECQ-L 2020.003

附件号: IECQ-L CEP 20.0003-S

版本号: 4

颁发日期: 2024/10/25

第 5 页 共 6 页

		15	物理尺寸	物理尺寸测量 JEDEC JESD22-B100B-2003
		16	锡球剪切	锡球剪切试验 AEC-Q100-010A-2003
		17	引脚完整性	引脚完整性 JESD22-B105E-2017
		18	机械冲击	机械振动-器件和组件 JEDEC JESD22-B110B. 01-2019
		19	变频振动	变频振动 JEDEC JESD22-B103B. 01-2016
		20	恒定加速度 试验	微电子器件试验方法 MIL-STD-883L-2019 方法 2001. 4
		21	密封试验	微电子器件试验方法 MIL-STD-883L-2019 方法 1014. 17
		22	芯片剪切	微电子器件试验方法 MIL-STD-883L-2019 方法 2019. 10
11	AECQ-101 分立器件试验	1	预处理	非密封表贴器件可靠性试验前 预处理 JEDEC JESD22-A113I-2020
				非密封表面贴装器件的湿度/回流焊敏感度分级 JEDEC J-STD-020F-2022
		2	目检	外观目检 JEDEC JESD22-B101D-2022
		3	高温反偏试验	半导体分立器件试验方法 第 2 部分 MIL-STD-750-1A-2016 方法 1038. 5、1039. 4
		4	高温栅偏试验	温度、偏置和工作寿命 JEDEC JESD22-A108G-2022
		5	温度循环	温度循环 JEDEC JESD22-A104F. 01-2023
		6	无偏置高加速压力 试验	加速湿度抵抗-无偏置高加速温湿度应力试验 JEDEC JESD22-A118B. 01-2021
7	高加速应力试验	带偏置高加速温湿度应力试验 JEDEC JESD22-A110E. 01-2021		

本附件与引用的证书同时使用时有效

本证书与附件如需复制使用, 应确保其完整性

本证书不得转让, 归发证机构管理

验证本证书与附件的状态和真实性可登陆 www.iecq.org 查询

广州赛宝认证中心服务有限公司

广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号 (511370)





国际电工委员会质量评定体系 (IECQ)

IECQ 规则及详情, 请登陆 www.iecq.org

独立实验室批准证书

范围附件

IECQ 证书号: IECQ-L CEP 20.0003

CB 证书号: IECQ-L 2020.003

附件号: IECQ-L CEP 20.0003-S

版本号: 4

颁发日期: 2024/10/25

第 6 页 共 6 页

8	高温高湿反向偏压	带偏置稳态湿热寿命试验 JEDEC JESD22-A101D.01-2021
9	间歇寿命试验	半导体分立器件试验方法 第 1 部分 MIL-STD-750-1A-2016 方法 1037.3
10	物理尺寸	物理尺寸测量 JEDEC JESD22-B100B-2003
11	引出端强度	半导体分立器件试验方法 第 2 部分 MIL-STD-750-2A-2018 方法 2036.5
12	耐溶剂性	印记持久性 JEDEC JESD22-B107D-2011
13	恒定加速度	半导体分立器件试验方法 第 2 部分 MIL-STD-750-2A-2018 方法 2006.2
14	变频振动	变频振动 JEDEC JESD22-B103B.01-2016
15	机械冲击	机械振动-器件和组件 JEDEC JESD22-B110B.01-2019
16	密封试验	密封 JEDEC JESD22-A109B-2011
17	耐焊接热	安装在单面板底面的小型表贴固态器件耐浸焊能力的评估流程 JEDEC JESD22-A111B-2018
		通孔安装器件的耐焊接冲击 JEDEC JESD22-B106E-2016
18	可焊性	元器件引脚, 焊端, 焊片, 端子和导线可焊性试验 J-STD-002E-2017
19	邦线拉力	半导体分立器件试验方法 第 2 部分 MIL-STD-750-2A-2018 方法 2037.1
20	邦线剪切	引线邦定剪切试验 AEC-Q101-003A-2005
21	晶片剪切	半导体分立器件试验方法 第 2 部分 MIL-STD-750-2A-2018 方法 2017.3

本附件与引用的证书同时使用时有效

本证书与附件如需复制使用, 应确保其完整性

本证书不得转让, 归发证机构管理

验证本证书与附件的状态和真实性可登陆 www.iecq.org 查询

广州赛宝认证中心服务有限公司

广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号 (511370)

